



主要用途

该器件为达林顿三极管内含阻尼二极管，用于高增益电路。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散($T_c=25$).....	65W
P_C ——集电极功率耗散($T_A=25$).....	2W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-120V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-120V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-5A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{CEO}	集电极—发射极截止电流			-0.2	mA	$V_{CE}=-100V, I_B=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.2	mA	$V_{CB}=-100V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-2	mA	$V_{BE}=-5V, I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	1000				$V_{CE}=-3V, I_C=0.5A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			-2	V	$I_C=-3A, I_B=-12mA$
				-4.0	V	$I_C=-5A, I_B=-20mA$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	120			V	$I_C=1mA, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	120			V	$I_C=5mA, I_B=0$